-Reviews-

創薬を指向した環境調和型有機金属触媒の開発とその応用

有 澤 光 弘

Development of Environmentally Friendly Organometallic Catalysis for Drug Discovery and Its Application to Heterocyclic Chemistry

Mitsuhiro ARISAWA

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University, Kita-12, Nishi-6, Kita-ku, Sapporo 060–0812, Japan

(Received April 26, 2007)

Two new catalysts, ruthenium hydride with a nitrogen-containing heterocyclic carbene (**A**) and an organopalladium catalyst supported on a sulfur-terminated semi-conductor, gallium arsenide (001) (**B**) were discovered. Both catalysts are environmentally benign, because **A** can yield indole derivatives with good atom economy, and **B** can catalyze the Mizoroki-Heck reaction more than 10 times with only trace amounts of leached palladium (ppb level). Substituted 1,2-dihydroquinoline, indole and 3-methylene-2,3-dihydroindole were also prepared selectively from the common starting material, *N*-allyl-*o*-vinylaniline, and catalyst by slight modification of the reaction conditions. These procedures address an important issue in diversity-oriented synthesis. These methods utility were demonstrated by application to biologically active natural products synthesis.

Key words-green chemistry; heterocycles; organometallic catalysis; Mizoroki-Heck reaction; ruthenium; palladium

1. はじめに

有機金属触媒を用いる炭素-炭素結合形成反応は 現在の有機合成化学に不可欠であり,基礎研究に留 まらず,創薬を始めとする応用研究,さらに工業的 にも広く用いられている.筆者らは創薬化学上有用 な新しい有機金属触媒や新しい反応の開発を目指し た研究を展開し,2つの新しい触媒の開発に成功し た(Scheme 1).含窒素複素環リガンドを有するル テニウムヒドリド(触媒 A)は「良好なアトムエ コノミーでインドール誘導体を合成できる」点,半 導体担持型有機パラジウム触媒(触媒 B)は溝路木 -Heck反応において「数十回利用が可能であり, かつ反応溶液中への金属種漏えい量がわずかであ る」点でいずれも環境調和型触媒となる.本総説で は、これら新触媒開発の経緯と生物活性天然物合成 への応用について述べる.

北海道大学大学院薬学研究院(〒060-0812 札幌市北区 北 12 条西 6 丁目)

e-mail: arisawa@pharm.hokudai.ac.jp

本総説は、平成19年度日本薬学会奨励賞の受賞を記念して記述したものである。

(H) = (H)

Scheme 1. Our New Environmentally Benign Catalysts

2. ルテニウム触媒(ルテニウムカルベン錯体及 びルテニウムヒドリド A)を用いた含窒素複素環 合成法の開発

2-1. ルテニウムカルベン錯体 遷移金属触媒 を用いるメタセシスは現在化学の注目すべき話 題¹⁻⁴⁾である.中でもここ 10 数年の間に開発された 第1世代 Grubbs 触媒 (**D**^{5,6)}, Fig. 1),含窒素複素 環カルベンリガンド (NHC)を有する第2世代



Fig. 1. Ruthenium Catalysts

Grubbs 触媒 (\mathbf{E}^{7-9}) や第2世代 Hoveyda-Grubbs 触媒 (\mathbf{G}^{10}) は高い官能基許容性,取扱容易性を持 ち市販もされていることから生物活性化合物の合成 を始めとする様々な分野で汎用されている.

筆者らはこれらの試薬が市販される前から, 閉環 メタセシス (ring-closing metathesis: RCM) を用い る含窒素複素環 (二環性ラクタム, アザシクロウン デセン, 軸不斉マクロラクタム, 1,2-ジヒドロキノ リン, 2-キノリノン等)新規合成法の開発と種々 の生物活性天然物 ((-)-coniceine, (S)-pyrrolam A, angustureine) の合成への適応について報告してき た.¹¹⁻³⁰⁾ 紙面の都合上, これらの詳細については, 参考文献の提示に留めたい.

2-1-1. シリルエノールエーテルメタセシス^{16,21)} キニーネやクロロキンに代表される顕著な生物活性 を有するキノリンアルカロイドの多くはキノリン環 の4位に置換基を有する.既に筆者らは閉環メタセ シスを用いる 1,2-ジヒドロキノリン合成法を開発 していたが,環構築後のキノリン環4位への置換基 導入が困難であることを鑑み,4位に酸素官能基を 有する 1,2-ジヒドロキノリンを一挙に構築できる シリルエノールエーテルメタセシス,アルキルエ ノールエーテルメタセシスについて検討し,シリル エノールエーテルメタセシスの開発に世界で初めて 成功した.

すなわち,市販の o-アミノアセトフェノンから アルキルエノール体(1a)及びシリルエノール体 (1b)を合成し,触媒 D や E と反応させた(Table 1). 1a あるいは 1b を触媒 D で処理したところ, 目的の環化体は全く得られず,いずれも定量的に原 料を回収した.しかし,触媒 E に替えて検討した ところ,対応する環化体(2a, 2b)がそれぞれ 95 %の収率で得られた.本法は数十グラムスケールで も問題なく進行する.本法を応用し,クロロキン, Table 1. Effect of Ru-catalyst on the Ene-enol Metathesis of **1a** and **1b**



Entry	Substate	Ru-catalyst	Conc. (M)	Product (%)
1	1 a	В	0.01 ^{<i>a</i>)}	2a (0)
2	a	С	0.01 ^{<i>a</i>})	a (95)
3	b	В	0.01 ^{<i>a</i>})	b (0)
4	b	С	0.01 ^{<i>a</i>})	b (95)
5	b	С	0.01 ^{b)}	b (99)
6	b	С	0.1 ^{<i>a</i>)}	b (96)
7	b	С	0.1 ^{b)}	b (97)

a) Degassed conditions. b) Without degassing.

PPMP-キニーネハイブリッドの合成鍵中間体を合成した.

2-2. ルテニウムヒドリド A

2-2-1. 末端オレフィンの選択的異性化と置換イ ンドール新規合成法の開発¹²⁾ 次に分子内シリル エノールエーテルメタセシスの分子間反応への応用 について検討した. 5 mol%の触媒 E と 10 当量の ビニルオキシトリメチルシラン(4a)を用いて末端 オレフィン(3)との反応を種々検討した結果,期



有澤光弘

北海道大学大学院薬学研究院准教授. 千葉大学薬学部卒業.同大学院博士前 期課程修了.大阪大学大学院薬学研究 科博士後期課程修了.千葉大学薬学部 助手.ハーバード大学化学科文部科学 省在外研究員(併任).北海道大学大学 院薬学研究科助教授.2005年より現 職.専門:創薬化学・有機合成化学・ 有機金属化学 待したシリルエノールエーテルのクロスメタセシス には成功しなかったものの、末端オレフィンが1つ だけ内部に異性化することを見出した(Table 2). 本異性化反応は末端一置換オレフィンにのみ有効で ある (Table 3).

既にメタセシスが進行し難い基質に対するルテニ ウムカルベン錯体による末端オレフィンの異性化が 報告されている30)が、私達の反応条件はメタセシス が進行し易い基質を用いた場合でも、優先的に末端 オレフィンの異性化が進行する点で特長がある。例 えば、本条件を N- アリル -o- ビニルアニリン(8a) に適応すると、RCM体は全く得られず、末端オレ フィンの選択的異性化が選択的に進行し.9aが定 量的に得られた. なお、本基質の対応する芳香族エ

3

ナミドへの変換は1当量の4aを用いれば十分に進 行することが分かった(Table 4).得られた 9a と 5 mol%の E をベンゼン中1時間加熱還流すると、 インドールが定量的に得られる. これは、芳香族エ ナミドメタセシス及び RCM を利用したインドール 合成の最初の例である. インドール合成法の開発 は、天然物アルカロイド合成や医薬化学の分野にお ける重要な課題の1つである.31)そこで、芳香族ア ミノ基上の保護基について検討したところ、芳香族 アミンの保護基はスルホンアミドに限定されず.ア シル体やカルバミン酸エステル体でも芳香族エナミ ドを経て対応するインドールを収率よく与えること が分かった (Table 5).

さらに、新しいインドール合成法の一般性と反応

Ethers in the Presence of	Ruthenium Carben	e Catalyst (E)
	E (5 mol%) CH ₂ Cl ₂ (12.5 mM)	

50 °C

5

Fable 2.	Reaction	of 3	with	Various	Sily	Enol	Ethers	and	Vinyl
Ethers	in the Pres	sence	of Ru	thenium	Carbo	ene Ca	atalyst ((E)	

Entire		Enol ether	s	Time	5(%)	E/Z ratio
Littiy		R	eq.	(h)	3(70)	of 5 ^{<i>a</i>)}
1	4a	TMS	2	20	60	2.6/1
2	4a	TMS	10	3	Quant	3.5/1
3	4b	Ac	10	23	NR	
4	4c	Et	10	3	12	b)
5	4c	Et	10	24	Quant	3.2/1

a) The ratio were determined by ¹H-NMR. b) Not determined.

4

	E (5 mol%)	
R ¹	+ = / CH CL 50 °C	R1 Jun
6a - g ^{R²}	4a (10 eq.)	7a-g ^{R²}

Table 3. Novel Isomerization of Various Terminal Olefins

Entry	Substrate	\mathbf{R}^{1}	R ²	Time (h)	Yield (%) ^{<i>a</i>)}	$E/Z^{b)}$
1	6a	Ph	Н	1.5	quant (34)	12.8/1
2	6b	PhCH ₂	Н	3.0	58	2.8/1
3	6c	p-MeOC ₆ H ₄ CH ₂	Н	3.0	78	8.5/1
4	6d	$HO(CH_2)_3$	Н	3.0	quant (34)	6.1/1
5	6e	$BnO(CH_2)_3$	Н	3.0	quant (96)	8.2/1
6	6f	BnO	Н	3.0	73	1/1.25
7	6g	BnOCH ₂	CH_3	3.0	NR	_

a) Yields in parenthesis indicate the isolated yields. b) Determined by ¹H-NMR.



Table 4. Optimization of the Amount of 4a for 8a

a) Mixture of enamide, 1,2-dihydroquinoline and indole (0.41/0.17/1).



N P	1) E Cl 2) E re	(5 mol%), 4a (1 eq.) H ₂ Cl ₂ , reflux, 1.5 h (5 mol%), benzene flux, 1 h	→ N P
8			10
Entry	S	ubstrate	Yield (%)
Entry		Р	10
1	8a	Ts	94
2	8m	Ac	82
3	8n	Bz	86
4	80	Boc	80
5	8p	Cbz	86 ^{<i>a</i>)}
6	8q	Ms	75

a) Reaction time of RCM was 16 h.

性を明らかにするため、ベンゼン環上の置換基の影響について検討した(Table 6).3位が置換した化合物(8e, 8j, 8k)の場合は立体的あるいは電子的な要因によりインドール体の収率は中程度に留まったが、他の基質では収率よく対応するインドール体(10)が得られることが分かった.現在、本インドール合成法を用いた医薬化学上、重要な分子の創製研究を展開中である.

2-2-2. 環化異性化反応を用いるインドリン新規 合成法の開発 上述した末端オレフィンの異性化 のメカニズムの考察から,さらに高温条件で本反応 を行えば,環化異性化体が得られるのではないかと 考えた(Table 7). 8a を塩化メチレン中,加熱還 流すると、**9a** が優先的に生成する (entry 1). 一 方、キシレン中、加熱すると、予想していた通り、 環化異性化反応が進行し、**11a** が主生成物として得 られた (entry 4). なお、本反応を 10 mol%の触媒 E 共存下で行うと、**11a** の収率は 81%に向上した (entry 5).

次に、芳香族アミンの保護基について検討したと ころスルホンアミド体、アシル体、カルバミン酸エ ステル体いずれの場合も、環化異性化反応が進行す ることが分かった(Table 8).非共有電子対の補足 能力が低いアシル体やカルバメート体を用いた場合 は、環化異性化反応生成物 11 とともに芳香環化し た 12 も得られる.

本反応の一般性と反応性に関するさらなる情報を 得るために、芳香環上の置換基について検討したと ころ、8b、8f、8gを除くすべての基質が対応する環 化異性化体を与えることが分かった(Table 9). さ らに、本手法を3-メチレン-2,3-ジヒドロベンゾフ ラン(14)の合成に応用すると、13dを除きすべて の基質が対応する環化異性化体を与えることが分か った(Table 10).なお、スチレンの3位に置換基 を有する基質(8b, 8f, 8g, 13d)では、エナミド (あるいはビニルエーテル)とスチレンが立体的に 反発し、環化異性化体が得られなかったものと推定 している.

次に,様々な官能基を持つ N-アルケニル -o-ビ ニルアニリンに対する環化異性化反応を試みた (Table 11).例えば, 8r, 4a (1 当量)とEをキシ レン中2時間加熱還流すると,環化異性体である



Entry		Substrate	Reaction con-	Reaction conditions of Step 2			
		Х	Solvent	Reaction time	10	9	
1	8a	Н	Benzene	1	94	_	
2	8b	6-OMe	Benzene	1	83	_	
3	8c	5-OMe	Toluene ^{<i>b</i>,<i>c</i>)}	16	96	_	
4	8d	4-OMe	Benzene	3	100	_	
5	8e	3-OMe	Toluene ^{b,d)}	32	54	46	
6	8 f	4,5,6-triOMe	Toluene ^{b)}	17	83	_	
7	8g	6-Cl	Toluene ^{b)}	4.5	85	_	
8	8h	5-Cl	Toluene ^{b)}	13	79	_	
9	8i	4-Cl	Toluene ^{b)}	2	86	_	
10	8j ^{<i>a</i>)}	3-Cl ^{<i>a</i>)}	Toluene ^{b)}	24	33	67	
11	8k	3-Me	Toluene ^{b)}	24	20	80	
12	81	6-Me	Benzene	1	77	—	

a) The Reaction time of Step 1 was 4 h. b) Degassed. c) $10 \mod \%$ of E was employed. d) $20 \mod \%$ of E was employed.

∧ ∧ Ts 8a	× .	E 4a (TMS 1 equiv.) ons 9a	» مرکم بر ا		N Ts 11a
=	Enter	Е	Conditions	Yield [%] a)	:
	Entry	[mol%]	Conditions	9a	11a	
-	1	5	CH ₂ Cl ₂ reflux, 1.5 h	Quant	0	
	2	5	Toluene, 40°C, 2 h	97	3	
	3	5	Toluene, reflux, 2 h	65	35	
	4	5	Xylene, reflux, 2 h	30	68	
	5	10	Xylene, reflux, 2 h	12	81	

Table 7. Isomerization and Cycloisomerization of Diene 8a

a) Yields were estimated by ¹H-NMR spectroscopy.

11r (58%) がエナミド 9r (26%) を伴って得られた (entry 1). あとの変換の手掛かりとなる官能基としてエステルを持つ 8s や 8t の環化異性化反応は不成功であったが、この場合にもエナミド (9s, 9t)がそれぞれ 32%、34%の収率で得られた (entris 2, 4).

ここで、エナミドが得られるものの、環化異性化

体が得られない理由について考えてみた. 触媒がエ ナミド生成の段階で失活する可能性を想定し, 既存 のルテニウムヒドリドを用いてエナミド(9s, 9t) を合成し, 9s, 9t を環化異性化反応に付した結果, 環化異性化体(11s, 11t)がそれぞれ 66%, 80%の 収率で得られたことから, エナミドが環化異性化反 応の中間体であることを実験的に証明した.

N P		E (10 r 4a (1 xyle reflux	nol%) eq.) ne , 2 h	N P	
8				11	12
	Entry	Sub	strate	Yield (%)	
	Entry		Р	11 and 12 (ratio of 1	11/12)
	1	8a	Ts	81 (100/0)	
	2	8m	Ac	69 (57/43)	
	3	8n	Bz	86 (86/14)	
	4	80	Boc	92 (84/16)	
	5	8p	Cbz	99 (79/21)	
	6	8q	Ms	86 ^{<i>a</i>)} (100/0)	

Table 8. Cycloisomerization: Substituent Eeffect on Nitrogen

a) 3 eq. of 4a was used.





a) Enamide was obtained quantitatively.

3-メチレン -2,3-ジヒドロインドール(11)のエ キソメチレンは合成上有用な官能基と考えられる. 実際, Boger ら³²⁾や坂本ら³³⁾はヒドロホウ素化に続 く酸化を経たヒドロキシメチル基への変換,中川 ら³⁴⁾や Lectka ら³⁵⁾はイミノーエン反応を経たトリ プトファンやトリプタミン誘導体への変換を報告し ている.われわれは新たに 11のオゾン酸化を経る カルボニル基への変換や, RCM を経るカルバゾー ル誘導体への変換を見出した (Scheme 2). したが って, *N*-アリル -*o*-ビニルアニリンの環化異性化 反応は 2,3-二置換インドールの新しい合成法とな ることが明らかになった.

われわれが開発した合成法は*N*-アリル -*o*-ビニ ルアニリン(8)と触媒 E を用い,若干の反応条件

Entry	Substrate	Product	Yield (%)
1	0 13a	14a	78
2	MeO 13b	MeO 0 14b	76
3	MeO	MeO	73
4	OMe 13d	OMe	27 <i>ª</i>)

Table 10. Cycloisomerization to Benzofuran Derivatives

Conditions: E (10 mol%), 4a (1 eq.), toluene, 2 h, reflux. a) 62% of 13d was recovered.

Entry Substrate Product (yield, %) Recovery (%) 1 N Ν Τs Τs Τs 8r 9r (26) **11r** (58) 2 N Ts N Ts CO₂Me CO₂Me **8s** (57) **9s** (32) 8s 3 CO₂Me N CO₂Me Τs Τs **9s** (21) 9s 11s (66) CO₂Me 4 CO₂Me `Ń Ts `N´ Ts 8t **9t** (34) 11t (52) 5 CO₂Me CO₂Me N Ts Ν 9t (20) Τs 9t 11t (80)

Table 11. Cycloisomerizarion of Dienes

Conditions: E (10 mol%), 4a (1 equiv.), xylene, reflux, 2 h.



Scheme 3. Diversity-oriented Synthesis of Heterocycles

を変えるだけで,創薬化学上重要な1,2-ジヒドロ キノリン,インドール,インドリンを作り分けるこ とができる点で優れたものである (Scheme 3).³⁶⁾

2-2-3. オレフィン異性化と環化異性化反応の活性種 上記のルテニウム触媒を用いる方法,すなわち RCM,オレフィン異性化,環化異性化反応はすべてアルゴン風船程度の雰囲気で円滑に進行する.そこで,まず,シュレンクを用いて,オレフィン異性化と環化異性化反応の活性種解明を種々試みたが,成功しなかった.一方,酸素濃度及び水分濃度が1 ppm 以下のグローブボックス内で反応を検討した結果,Eと4aが反応し定量的にAを与えることを見出した(Scheme 4).触媒Aは通常の雰囲気では容易に分解するが,グローブボックス内では分解せず,保存することも可能である.MolらはRuClH(CO)(PCy₃)2のリガンド交換によるAの合

成を報告している.³⁷⁾ また, Grubbs らは E がメタ ノール中で一部分解し A が生成することを報告し ている.³⁸⁾ しかし,いずれの方法も,A を高純度で 得ることができず,触媒能に関する報告はわれわれ が知る限り皆無であった.しかし,われわれの方法 は高純度の A を温和な条件下簡便に得ることがで きるので,A が末端オレフィン異性化や環化異性 化反応を触媒することを世界で初めて見出すことが できたと考えている.

E と 4a をトルエン中(0.01M) 50℃で1時間撹 拌すると Grubbs ら³⁸⁾が報告しているように,フィ ッシャーカルベン錯体 F が定量的に得られる.さ らに F をトルエン中加熱還流すると A が定量的に 得られる.過剰量の 4a は F から A への変換に影響 しない.また,F は RCM の触媒となるが,末端オ レフィンの異性化や環化異性化の触媒とはならな



F stable

Scheme 4. Quantitative Conversion of E to A

い. これらのことを総合的に考察すると,われわれの反応系では,4aとEが選択的に反応し,Fを経てAが生成したものと考えられる.

2-2-4. 環化異性化反応を鍵反応とするフィスツ ロシンとして提唱された構造を持つ化合物の合成 ジエンの環化異性化反応はアトムエコノミーよく新 しい環を形成できる有用な反応であるが,従来の環 化異性化反応では基質が限定されたり,官能基許容 性が低いなどの問題があり,本反応を生物活性天然 物の合成に応用した例はなかった.そこで,われわ れは抗菌活性インドールアルカロイドであるフィス ツロシンを環化異性化反応のターゲットとして選 び,その合成に初めて成功した (Fig. 2).驚いた ことに合成品の各種スペクトルデーターは天然物の それと一致せず,結果として天然のフィスツロシン が提唱構造以外の化合物であることを明らかにする ことになった.

3. 半導体担持型有機パラジウム触媒(触媒 B)の開発

医・農薬などのファインケミカルやその他の化学 工業分野における有機合成では、均一系有機金属触 媒が広く使用されている.このプロセスは反応効率 が高く有用な手法であるものの、反応後に触媒金属 と合成原料・生成物との分離が困難であるため、使 用済み触媒の再利用ができず、大量の廃棄物が生じ ることが問題となっている.また、近年は中国・イ ンドを始めとする新興諸国の急速な経済発展によ り、資源争奪の様相が生じ始めており、高活性触媒 としての応用が期待される白金族金属(Pt, Pd, Ir, Ru など)の価格が高騰していることから、触媒の



Fig. 2. Putative Structure of Fistulosin

リサイクルが年を追う毎に、重要課題になっている.

一方,分離が容易で再利用が可能な不均一系の固 相担持型触媒が種々報告されているが,均一系触媒 とこれら不均一型触媒を比較すると,有機合成化学 上重要な炭素-炭素結合形成反応では,一般的に活 性が低く,現状でも,不均一触媒の触媒活性向上の ために様々な検討が行われている.³⁹⁻⁴³⁾上記の状況 下,環境負荷の低減,資源の有効利用という観点か らも高活性な新規固相担持型触媒の開発はもはや社 会的要請となっている.

筆者らは均一系触媒・不均一系触媒のそれぞれが 抱える問題を解決することを目的とし,取り扱いが 容易でリサイクルが可能,かつ炭素一炭素結合形成 反応において従来の触媒を凌駕する特性を示し,環 境的・経済的負荷の少ない新しいコンセプトに基づ いた触媒の開発を目指し,「ナノテクノロジーを用 いた半導体担持型有機金属触媒」の開発を推進して いる(Fig. 3).筆者らの開発コンセプトの詳細は, 以下の3点である.

1)既存の均一系有機金属錯体触媒,不均一系固相担 持型触媒よりも高活性な触媒の開発.

2) 医・農薬,電子材料などの広範囲な化学工業分野 で使用できる汎用性の高い触媒の開発.

3) 従来の固体担持触媒では不可能であった光学活性 触媒等,高度機能化触媒の開発. これらの目的を達成するため,筆者らは触媒担持 固体として半導体に着目した.すなわち,半導体と 触媒金属とを結合子を介して結合すれば,今まで報 告例のない,全く新しい触媒を開発できるのではな いかと考えた.本稿では,本研究におけるわれわれ の研究経過について紹介する.

3-1. 硫黄終端半導体担持型パラジウム触媒の作 製と溝呂木一Heck 反応における触媒活性 筆者 らは半導体としてガリウムヒ素基板:GaAs(001), 結合子として硫黄:S, 触媒金属としてパラジウ ム:Pdを選択し,本研究に着手した.硫黄原子の 結合状態の違いによる触媒活性の変化を検討するた め,2通りの硫黄吸着法で触媒を調整した.GaAs (001)基板への硫黄終端操作に分子線エピタキシ装 置(MBE: Molecular Beam Epitaxy)を用いたも のを第1世代触媒,多硫化アンモニウム((NH₄)₂



Fig. 3. Concept of Catalyst B

 S_x)を用いたものを第2世代触媒として以下に紹介 する.

3-1-1. 第1世代触媒(MBE法) 塚本の開 発した硫黄終端 GaAs (001) 基板にパラジウムを定 着する方法.⁴⁴⁻⁴⁷⁾まず, MBE を用いて, 13×11 mm²の GaAs (001)を成長させたのち,極高真空下 GaAs (001)に (2×6)構造を有する硫黄単原子層を 形成し, S-GaAs (α)を調製した (Scheme 5:操 作①②).続いて, S-GaAs (α)をPd(PPh₃)₄のベ ンゼン溶液中,室温で3分間浸し,Pd-S-GaAs (触 媒 I)を製造した (操作③).触媒 I の溝呂木-Heck 反応 (Scheme 6)における触媒活性を測定したと ころ,1回目から3回目までの収率がそれぞれ35%, 13%,9%と複数回利用できることが分かった (Table 12).⁴⁸⁾

この萌芽的結果を受け,触媒の調整についてさら に検討した.先と同様に作製した S-GaAs (α)を Pd (PPh₃)₄のアセトニトリル溶液中,12時間加熱 還流を行い Pd-S-GaAs (触媒 II)を製造した(操 作③).半導体上の硫黄と結合せず,単に表面に付 着している過剰のパラジウムは化学反応中の会合に より硫黄と結合したパラジウムを不活性化すること が考えられるが,これら過剰パラジウムは加熱洗浄 により除去できると考え,⁴⁹⁻⁵¹⁾別途,触媒 II に加熱 洗浄(アセトニトリル溶液中12時間加熱還流)処



Scheme 5. Preparation of Catalyst B: MBE Method



Scheme 6. Mizoroki-Heck Reaction

Entry Cat.	Cat	Hostod washing					Yield	of 15a	[%] ^{a)}				
	Heated-washing	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	ave.	
1	I	No	35	13	9	_	_	_	_	_	_		_
2	II	No	81	60	41	36	32	13	12	1	1	0	28
3	III	Yes	99	88	95	92	87	86	67	60	62	73	81

Table 12. Chemical Yield of 1st-generation Catalysts in Repeated Use

a) Isolated yields.

Table 13. Effect of Pd Sources in 2nd-generation Catalysts

Entry	Cat	Dd couroo	Yield of 15a [%] ^{<i>a</i>}										
Litty Cat	Cal.	Fu source	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	ave.
1	IV	$Pd(PPh_3)_4$	93	87	71	72	57	54	35	37	25	24	56
2	V	PdCl ₂	1	1	0								
3	VI	$Pd(acac)_2$	51	31	14	15	10	12	1				
4	VII	$Pd(CH_3CN)_2Cl_2$	43	8	1	0	1						
5	VIII	$Pd(dba)_2$	74	66	31	46	12	9	5	1	1	4	25
6	IX	$Pd(OAc)_2$	100	99	91	98	97	88	81	72	71	79	88

a) Isolated yields.



Scheme 7. Preparation of Catalyst B: Chemical Method

理を施した触媒 III を調整した.得られた各々を溝 呂木-Heck 反応に用いた結果,触媒 II が触媒 I よ りも高い活性を有していること,また,触媒 III が 触媒 II よりも高い活性を有していることが明らか (Table 12) になり,パラジウム定着を高温条件で 行うことと,パラジウム定着後に加熱洗浄処理を施 すことが高い活性を有する触媒を製作する上で重要 であることが明らかとなった.⁵²⁾

3-1-2. 第2世代触媒((NH₄)₂S_x法) MBE は高価な機器であるので、どこでも簡便に触媒製造 ができる化学的手法を開発するべく、(NH₄)₂S_x⁴⁸⁾ を用いて硫黄終端操作を行った. すなわち、13×11 mm²の GaAs(001)を多硫化アンモニウム水溶液 3 ml 中、60°C で 30 分加熱し、S-GaAs (β)を調製し た (Scheme 7:操作①). 続いて、S-GaAs (β) を 有機パラジウム触媒のアセトニトリル溶液中、12 時間加熱還流し、Pd-S-GaAs (触媒 IV-IX) を製 造し、(操作②) 各々溝呂木-Heck 反応に付した (Table 13). その結果, 硫黄終端操作に多硫化アン モニウムを用いても, パラジウム源として塩化パラ ジウムを用いると, 溝木-Heck 反応において, 10 回目の収率が79%, 平均収率(1回目から10回目) 88%の触媒活性を有する新しいパラジウム触媒が得 られることが分かった(触媒 IX).

続いて、多硫化アンモニウムを用いてパラジウム 触媒を作製した場合の加熱洗浄効果について検討し た.酢酸パラジウムをパラジウム源とした場合は、 第2世代触媒においても加熱洗浄効果のあることが 確かめられ⁵³⁾(Table 14),この方法で作製した触 媒 XII がここまでの研究で最も高い触媒活性を示 した.

そこで、加熱洗浄条件、特に溶媒と温度について 詳細に検討したところ、アセトニトリル中 100℃、 あるいはキシレン中 135℃ で洗浄した触媒 XII 及 び触媒 XVIII が最もよい触媒活性を示した(Table 15).⁵⁴⁾

	Table 14. Effect of Heated Washing 1																		
Entry	Cat.	Cat Pd source	t Pd source	Heated	ted Yield of 15a [%] ^{<i>a</i>}														
			washing	1 st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	ave.					
1	IV	$Pd(PPh_3)_4$	No	93	87	71	72	57	54	35	37	25	24	56					
2	Х	$Pd(PPh_3)_4$	Yes	90	55	67	66	57	54	46	43	43	39	56					
3	XI	$Pd(OAc)_2$	No	100	99	91	98	97	88	81	72	71	79	88					
4	XII	$Pd(OAc)_2$	Yes	96	100	91	93	98	100	96	99	98	95	97					

a) The yields were determined by NMR analysis.

Yield of 15a $\lceil \% \rceil^{a}$ Heated washing Entry Cat. Solvent $T [^{\circ}C]^{b}$ 4th 5th 6th 7th 10th 1st 2nd 3rd 8th 9th ave. XII MeCN XIII Toluene DMF XIV XV DMSO XVI DMF XVII Toluene XVIII Xylene XIX Xylene

Table 15. Effect of Heated Washing 2

a) The yields in entry 1 were determined by NMR analysis. The yields in entries 2 to 8 were determined by HPLC analysis. b) Bath temperature.



Scheme 8. Chemical Yield and Leached Pd on Each Mizoroki-Heck Reaction Using Catalyst XII

触媒 XII あるいは触媒 XVIII の機 3-2. 特徴 能について調査した. すなわち, 反応液中へのパラ ジウム漏えい量、定着されているパラジウムの価 数,触媒表面状態を知る目的で,実験を行った.

3-2-1. 反応液中へのパラジウム漏えい量 触 媒 XII 及び触媒 XVIII を繰り返し溝呂木-Heck 反 応に付したときの、各反応溶液中のパラジウム量を 誘導結合プラズマ質量分析 (ICP-Mass) を用いて 測定した (Schemes, 8, 9). 両触媒とも, 担持され



Scheme 9. Chemical Yield and Leached Pd on Each Mizoroki-Heck Reaction Using Catalyst XVIII

たパラジウム量は 100-300 μg であり、ほとんど変 わらなかったが、アセトニトリル中100℃で加熱洗 浄した触媒 XIIの5回目以降のパラジウム漏えい 量が数 µg であったのに対し、キシレン中 135℃ で 加熱洗浄した触媒 XVIII のそれは数十 ng と 2 桁レ ベルの違いがあった.原因解明には、さらなる実験 が必要と考える.

3-2-2. 担持されたパラジウムの価数 触媒 XIIのX線光電子分光法(XPS)実験を行った.



I: before Heck reaction II: after Heck reaction (10 times)

Scheme 10. XPS Result of Catalyst XII



a. GaAs(001) (x 1,500)



c. catalyst **XII** after the Heck reaction (x 1,500)

Pd 3d5/2 のピークは 335.9 eV であり, 金属パラジ ウムの値 (335.0 ev) に近かった (Scheme 10). こ れらのことから, パラジウム源が2価(酢酸パラジ ウム)であるにも係わらず, 担持されているパラジ ウムの価数は溝呂木-Heck 反応の前後ともに0価 であることが分かった. なお, 0価パラジウムは一 般的に不安定とされている.

3-2-3. 触媒表面の顕微鏡観測 触媒 XII の表面を走査電子顕微鏡 (SEM) を用いて観察した. 繰り返し反応の前後で,触媒能に変化がないことは記述の通りであるが, SEM 画像では繰り返し反応の前後で表面の状態が変化している (Scheme 11).

3-3. 本触媒の汎用性 反応液中へのパラジウ ム漏えい量が少ない触媒 XVIII の汎用性について 検討した. その結果,本触媒はヨウ化ベンゼンとは 反応するが,臭化ベンゼンやトリフルオロフェノー ルとは反応しないこと,ベンゼン環上の置換基が反



b. catalyst **XII** before the Heck reaction (x 1,500)



d. catalyst **XII** after the Heck reaction (x 10,000)

Scheme 11. SEM Result of Catalyst XII

応性に影響することが分かった(Table 16). また, 活性化されているヨードベンゼンよりも不活性化さ れているヨードベンゼンの方が反応性が高かった (entries 3-6 と 8-9 を比較)原因を考察すると,半 導体が反応メカニズムに係わっている可能性があ る. この点についても今後の実験結果が待たれると ころである. さらに,アクリル酸メチルの代わりに メチルビニルケトンを用いて本触媒の一般性を検討 した(Table 17). 1回目の化学収率は76%であっ たが,この収率が10回目まで維持された.

筆者らは本触媒の反応機構解明を目指した実験も

行っている.54)

まとめ

筆者らはルテニウムカルベン錯体を用いた含窒素 複素環新規合成法開発と種々の生物活性化合物合成 を遂行した.さらに,第2世代 Grubbs 触媒と電子 供与性オレフィン(ビニルオキシトリメチルシラン) が,含窒素複素環リガンドを有するルテニウムヒド リド(触媒 A)を与えることを見出し,本触媒を 用いた新反応(末端オレフィンの選択的異性化,環 化異性化反応)開発,含窒素複素環新規合成法開発 と生物活性化合物合成を達成した.

	Table 16.	Reaction of	of Catalyst	XVIII with	1 Various	Aromatic Halides
--	-----------	-------------	-------------	-------------------	-----------	------------------

Ar-X +	o ↓ OMe	{Pd}-S-GaAs (XVI Et ₃ N (1.25 eq) MeCN (3 ml) $100 \degree$ C 12 b	Ar OMe
13	14a	100 C, 12 II	15
(0.5 mmol)	(1.25 eq)	over 10 times	

Entre		Substrate [Ar-X]		Yield [%] <i>a</i>)											
Entry		Ar	Х		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	ave.
1	13b	C_6H_5	Br	15a ^{b)}	0	0	0 ^{c)}	0 ^{<i>d</i>)}	0 ^{e)}	_	_	_	_	_	0 ^{<i>f</i>)}
2	13c	C_6H_5	OTf	15a ^{b)}	0	0	0 ^{<i>c</i>)}	0 ^{<i>d</i>})	0 ^{<i>e</i>)}	_	_	_		_	$0^{f)}$
3	13d	$2-MeC_6H_4$	Ι	15b	98	90	94	81	72	63	52	49	43	36	68
4	13e	$3-MeC_6H_4$	Ι	15c	100	100	100	72	62	56	59	47	46	38	68
5	13f	$4-MeC_6H_4$	Ι	15d	100	100	100	100	100	100	100	100	98	96	99
6	13g	$4-MeOC_6H_4$	Ι	15e	100	92	100	87	75	89	68	48	50	54	76
7	13h	$2-BrC_6H_4$	Ι	15f	92	71	80	57	65	58	36	28	28	25	54
8	13i	$3-BrC_6H_4$	Ι	15g	100	100	81	57	47	39	40	38	25	29	56
9	13j	$4-BrC_6H_4$	Ι	15h	98	81	67	56	65	49	42	41	38	42	58
10	13k	$4-NO_2C_6H_4$	Ι	15i	82	34	10	4	0		_				$26^{(f)}$
11	13I	$4\text{-}MeC(O)C_6H_4$	Ι	15j ^{g)}	91	59	51	44	38		_	_			57^{f}
12	16	Xylene	Ι	17	99	100	100	99	94	100	83	92	91	83	94

a) Yields were determined by ¹H NMR spectra (PhNO₂ (0.25 mmol) was employed as an internal standard.). b) Yields were determined by HPLC analysis. c) Reaction time was 24 h. d) Reaction was carried out in toluene at 135°C (bath temperature) for 12 h. e) Reaction was carried out in toluene at 135°C (bath temperature) for 24 h. f) Average yield through 1 to 5 runs. g) 0.50 mmol of acetophenone was used as an internal standard.

Table 17. Reaction of Catalyst XVIII with Various Methyl Vinyl Ketones

	0	Pd-S-GaAs (XV Et ₃ N (1.25 eq)	/III) 0
(<u> </u>	≪~ ^R	MeCN (3 ml)	Ph
13a	14	100 C, 12 II	15
(0.5 mmol)	(1.25 eq)	over 10 times	

Entry	Substr	ate [14]						Yield of	15 [%]	1)				
Entry		R		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	ave.
1	14a	OMe	15a	96	100	99	98	100	91	96	97	92	91	96
2	14b	Me	15k	76	80	79	78	77	76	72	75	74	71	76

a) Yields were determined by ¹H NMR spectra (PhNO₂ (0.25 mmol) was employed as an internal standard.).

また,筆者らは硫黄終端半導体(GaAs(001))が 有機金属触媒の固体担体となることを見出した.本 研究で得られた半導体担持型パラジウム触媒(触媒 B)はヨードベンゼンの溝路木-ヘック反応におい て数十回の複数回利用が可能であり,反応溶液中へ のパラジウム種漏えいもごくわずかであることが明 らかになった.現在,本触媒の構造解明やさらに実 用的な触媒の開発に取り組んでいる.

触媒 A は「良好なアトムエコノミーでインドー ル誘導体を合成できる」点, 触媒 B は溝路木-Heck 反応において「数十回利用が可能であり, かつ反応 溶液中への金属種漏えい量がわずかである」点でい ずれも環境調和型触媒となる.

謝辞 本研究の多くは千葉大学大学院薬学研究 院で行ったものであり,終始ご指導頂いた中川昌子 先生.西田篤司先生,絶えず温かく見守り励まして 下さった大阪大学大学院薬学研究科 北 泰行先 生, ルテニウムカルベン錯体 (C) の合成法・使用 法を教授頂いた北海道大学大学院薬学研究科 森 美 和子先生、さらに北海道大学異動後も本プロジェク トにご理解頂いた北海道大学大学院薬学研究院 周 東 智先生に感謝する、また、阿南工業高等専門学 校 塚本史郎先生,物質・材料機構 下田正彦先生を 始めとする共同研究者の皆様、Theeraladanon Chumpol 博士, 寺田幸芳博士, 濱田昌弘博士, Mohammad Gulam Rabbani 博士, 金子浩章修士, 長岐大修士, 高橋和之修士, 帯津紀子修士, 高宮郁 子修士, 宮下直樹修士, 渡邊崇之修士, 高橋真紀学 士を始めとする大学院生・学生諸氏の努力に感謝す る. ICP-Mass は千葉大学大学院薬学研究院 鈴木 和夫先生、小椋康光先生にご指導・御討論頂いたこ と、SEM はキーエンス㈱に測定頂いたこと、御礼 申し上げる. 最後に本プロジェクト遂行に当たり, 経済的支援を賜った以下の財団等に深謝する. 科学 研究費補助金(若手研究 A, 萌芽研究, IT プログ ラム)、 財池谷科学技術振興財団、 財矢崎科学技術 振興記念財団, 財医薬資源研究振興会, 財薬学研究 奨励財団, 財井上科学振興財団, 三菱化学研究奨励 基金,武田薬品工業㈱,三井化学㈱.

REFERENCES

- Connon S. J., Blechert S., Angew. Chem. Int. Ed., 42, 1900–1923 (2003).
- Deiters A., Martin S. F., Chem. Rev., 104, 2199-2238 (2004).
- Grubbs R. H., *Tetrahedron*, **60**, 7117–7140 (2004).
- 4) Armstrong S. K., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 371–388 (1998).
- Schwab P., Grubbs R. H., Ziller J. W., J. Am. Chem. Soc., 118, 100-110 (1996).
- Schwab P., France M. B., Ziller J. W., Grubbs R. H., Angew. Chem. Int. Ed., 34, 2039–2041 (1995).
- Scholl M., Trnka T. M., Morgan J. P., Grubbs R. H., *Tetrahedron Lett.*, 40, 2247– 2250 (1999).
- Scholl M., Ding S., Lee C. W., Grubbs R. H., Org. Lett., 1, 953–956 (1999).
- Chatterjee A. K., Grubbs R. H., Org. Lett., 1, 1751–1753 (1999).
- 10) Kingsbury J. S., Harrity J. P. A., Bonitatebus Jr. P. J., Hoveyda A. H., *J. Am. Chem. Soc.*, 121, 791–799 (1999).
- Arisawa M., Takezawa E., Nishida A., Mori M., Nakagawa M., *Synlett*, 1179–1180 (1997).
- 12) Nakagawa M., Uchida H., Torisawa Y., Nishida A., J. Synth. Org. Chem. Jpn., 57, 1004–1005 (1999).
- Arisawa M., Kato C., Kaneko H., Nishida A., Nakagawa M., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 1873–1876 (2000).
- 14) Arisawa M., Kaneko H., Nishida A., Yamaguchi K., Nakagawa M., Synlett, 841– 843 (2000).
- Arisawa M., Takahashi M., Takezawa E., Yamaguchi T., Torisawa Y., Nishida A., Nakagawa M., *Chem. Pharm. Bull.*, 48, 1593– 1596 (2000).
- 16) Arisawa M., Theeraladanon C., Nishida A., Nakagawa M., *Tetrahedron Lett.*, 42, 8029– 8033 (2001).
- Arisawa M., Kaneko H., Nishida A., Nakagawa M., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 959– 964 (2002).
- 18) Arisawa M., Terada Y., Nakagawa M., Nishi-

da A., Angew. Chem. Int. Ed., **41**, 4732–4734 (2002).

- Nagata T., Nakagawa M., Nishida A., J. Am. Chem. Soc., 125, 7484–7485 (2003).
- 20) Ono K., Nakagawa M., Nishida A., Angew. Chem. Int. Ed., 43, 2020–2023 (2004).
- Theeraladanon C., Arisawa M., Nishida A., Nakagawa M., *Tetrahedron*, 60, 3017–3035 (2004).
- 22) Terada Y., Arisawa M., Nakagawa M., Nishida A., *Angew. Chem. Int. Ed.*, **43**, 4063–4067 (2004).
- 23) Terada Y., Arisawa M., Nishida A., Chem. Times, 194, 2-10 (2004).
- 24) Theeraladanon C., Arisawa M., Nakagawa M., Nishida A., *Tetrahedron: Asymmetry*, 16, 827–831 (2005).
- Arisawa M., Terada Y., Theeraladanon C., Takahashi K., Nakagawa M., Nishida A., J. Organomet. Chem., 690, 5398-5406 (2005).
- 26) Arisawa M., Theeraladanon C., Nishida A., *Heterocycles*, **66**, 683–688 (2005).
- 27) Terada Y., Arisawa M., Nishida A., J. Org. Chem., 71, 1269–1272 (2006).
- 28) Arisawa M., Terada Y., Takahashi K., Nakagawa M., Nishida A., J. Org. Chem., 71, 4255-4261 (2006).
- 29) Arisawa M., Nishida A., Nakagawa M., J. Organomet. Chem., 691, 5109–5121 (2006).
- Arisawa M., Terada Y., Takahashi K., Nakagawa M., Nishida A., Chem. Record, 7 (2007) (in press).
- Nakamura I., Yamamoto Y., Chem. Rev., 104, 2127–2198 (2004).
- 32) Boger D. L., Ishizaki T., Wysocki Jr. R. J., Munk S. A., J. Am. Chem. Soc., 111, 6461– 6463 (1989).
- 33) Sakamoto T., Kondo Y., Uchiyama M., Yamanaka H., J. Chem. Soc., Perkin Trans.
 1, 1941–1942 (1993).
- 34) Yamanaka M., Nishida A., Nakagawa M., J.
 Org. Chem., 68, 3112–3120 (2003).
- 35) Ferraris D., Young B., Cox C., Dudding T., Drury III W. J., Ryzhkov L., Taggi A. E., Lectka T., J. Am. Chem. Soc., 124, 67–77 (2002).
- 36) Burke M. D., Schreiber S. L., Angew. Chem.

Int. Ed., 43, 46-58 (2004).

- Dinger M. B., Mol, J. C., Eur. J. Inorg. Chem., 2827–2833 (2003).
- Louie J., Grubbs R. H., Organometallics, 21, 2153-2164 (2002).
- 39) Fan Q. -H., Li Y. -M., Chan A. S. C., Chem. Rev., 102, 3385–3466 (2002).
- 40) Leadbeater N. E., Marco M., Chem. Rev., 102, 3217–3274 (2002).
- 41) Song C. E., Lee S. -G., *Chem. Rev.*, **102**, 3495– 3524 (2002).
- 42) Dupont J., de Souza R. F., Auarez P. A. Z., *Chem. Rev.*, 102, 3667–3692 (2002).
- Kobayashi J., Mori Y., Okamoto K., Akiyama R., Ueno M., Kitamori T., Kobayashi S., *Science*, 304, 1305–1308 (2005).
- 44) Tsukamoto S., Koguchi N., Appl. Phys. Lett.,
 65, 2199–2201 (1994).
- Tsukamoto S., Koguchi N., Jpn. J. Appl. Phys., 33, L1185–L1188 (1994).
- 46) Tsukamoto S., Koguchi N., J. Cryst. Growth, 150, 33-37 (1995).
- 47) Tsukamoto S., Ohno T., Koguch N., J. Cryst. Growth, 175/176, 1303–1308 (1997).
- 48) Arisawa M., Tsukamoto S., Shimoda M., Pristovsek M., Nishida A., Jpn. J. Appl. Phys., 41, L1197-L1199 (2002).
- 49) Herrmann W. A., Brossmer C., Öfele K., Beller M., Fisher H., J. Mol. Catal. A: Chem., 103, 133-146 (1995).
- 50) Beller M., Fisher H., Kühlein K., Reisinger C.
 P., Herrman W. A., J. Organomet. Chem., 520, 257–259 (1996).
- 51) Djakovitch L., Koehler K., J. Am. Chem. Soc., 123, 5990–5999 (2001).
- 52) Takamiya I., Tsukamoto S., Shimoda M., Arisawa M., Nishida A., Arakawa, Y. Jpn. J. Appl. Phys., 45, L475-477 (2006).
- 53) Takamiya I., Tsukamoto S., Shimoda M., Miyashita N., Arisawa M., Arakawa Y., Nishida A., Chem. Lett., 33, 1208–1209 (2004).
- 54) Arisawa M., Hamada M., Takamiya I., Shimoda M., Tsukamoto S., Arakawa Y., Nishida A., Adv. Synth. Cat., 348, 1063–1070 (2006).